**存储器实验引导**

1. 了解：存储器实验概述4.3.3。（P234-236）

2. # 了解 4.3.4 1.RAM的exp\_ram.vhd代码及读写操作（P237）。

提供参考图

1. 存储器部分教材图片
2. 图4-3-12存储器实验原理图
3. 存储器电路参考图

【实验】\*

4.3.4 2. LPM\_RAM\_IO定制~3.存储器实验。参考图4-3-12（P239）用电路图完成设计，或通路部分用语言描述，存储部分用定制，再用图形完成最后设计，如图4-3-13（P240），完成以下仿真：

① 置数法产生一个地址（如产生【01】H地址）；

将数据F0H→【01】H中；

读【01】中的数据；

② 计数法产生一个地址（如产生【05】H地址）；

将数据87H→【05】H中；

读【05】中的数据；

【日志记录】

【日志】# 分析仿真结果图4-3-14(P241)中200ns后执行读M【01】中数据时为何会先出现E1？